

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第7部門第2区分  
 【発行日】令和7年1月28日(2025.1.28)

【国際公開番号】WO2024/024878  
 【出願番号】特願2024-537219(P2024-537219)

【国際特許分類】

H 0 5 K 3/46(2006.01)

H 0 5 K 1/09(2006.01)

H 0 5 K 1/11(2006.01)

H 0 5 K 3/40(2006.01)

10

【F I】

H 0 5 K 3/46 N

H 0 5 K 3/46 B

H 0 5 K 1/09 C

H 0 5 K 1/11 H

H 0 5 K 3/40 E

【手続補正書】

【提出日】令和6年11月6日(2024.11.6)

20

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1面を有する第1絶縁層と、

前記第1面に位置するとともにビアホールを有する第2絶縁層と、

前記第2絶縁層を貫通するビア導体部と、

30

を備え、

前記ビア導体部は、前記第1面に位置するピアランド導体と、該ピアランド導体に接するとともに前記ビアホールに位置するピアホール導体とを有しており、

前記ピアランド導体は、前記ピアホール導体と接する接続部を含む第1層と、該第1層の前記第1絶縁層側と接する第2層とを、少なくとも有しており、

前記ビア導体部は、前記接続部を介して前記第1層と前記ピアホール導体とに跨る連続結晶を有しており、

前記第1層の第1結晶粒度は、前記第2層の第2結晶粒度と異なる、配線基板。

【請求項2】

40

前記第2結晶粒度は、前記第1結晶粒度よりも大きい、請求項1に記載の配線基板。

【請求項3】

前記ピアランド導体は、前記第2層の前記第1絶縁層側と接する第3層を、さらに含み、

前記第1結晶粒度および前記第3層の第3結晶粒度は、前記第2結晶粒度よりも小さい、請求項1に記載の配線基板。

【請求項4】

前記第1層の前記第2絶縁層側表面の算術平均粗さは、前記第3層の前記第1絶縁層側表面の算術平均粗さよりも小さい、請求項3に記載の配線基板。

【請求項5】

50

前記第 1 層の厚さは、前記第 2 層の厚さおよび前記第 3 層の厚さよりも大きい、請求項 3 に記載の配線基板。

【請求項 6】

請求項 1 ~ 5 のいずれかに記載の配線基板と、該配線基板の実装領域に位置する電子部品とを含む、実装構造体。

10

20

30

40

50